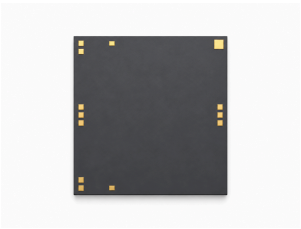
1200–2400 MHz GaN MMIC 功率放大器裸片

LCI-PA-1200-2400-PS45T 是覆盖 1200–2400 MHz 的 GaN MMIC 功率放大器裸片，支持连续波及脉冲工作。

RF 电气表参数: 饱和输出功率: 45 dBm (典型值); 功率增益: 25 dB (典型值); 功率附加效率: 53 % (典型值). RF 测试条件: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V. 裸片尺寸: 3.1 × 3.2 × 0.08 mm.



RF 特性

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	f	1200	-	2400	MHz
饱和输出功率	Psat	44.5	45	45.5	dBm
功率增益	Gp	24.5	25	-	dB
功率增益平坦度	ΔGp	-	-	±0.5	dB
功率附加效率	PAE	50	53	-	%

直流偏置与电流

TA = +25 °C

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
漏极电压	Vd	-	28	-	V
栅极电压	Vg	-3	-2.6	-2.2	V
静态漏极电流	Id	-	1.2	-	A
动态漏极电流	Idd	-	2.2	2.4	A
动态栅极电流	Igg	-	-	1	mA

极限参数

极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
漏源最大正向电压	Vd	-	-	32	-	V
栅极最低偏置电压	Vg	-5	-	-	-	V
最大输入功率	Pin	-	-	25	-	dBm
最高沟道温度	Top	-	-	225	-	°C
储存温度	TSTG	-65	-	150	-	°C
负载失配耐受能力	-	-	-	-	10:1	-

裸片尺寸

参数	数值	单位
裸片尺寸	3.1 × 3.2 × 0.08	mm
平面外形尺寸公差	±50 (仅对应平面外形；源资料未明确厚度公差。)	µm

当前出版记录 · 1.7 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.6.

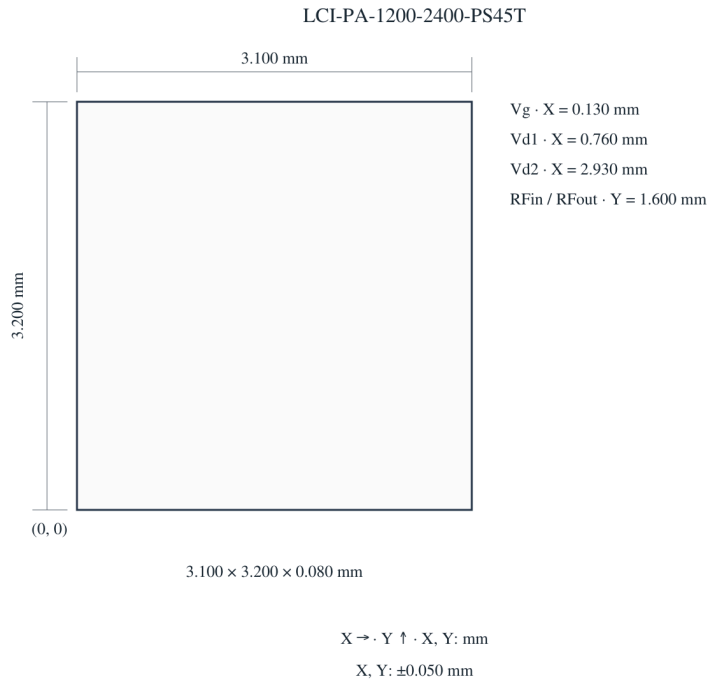
裸片集成与偏置时序

上电时先加栅极偏置，再加漏极偏置；断电时先撤去漏极偏置，再撤去栅极偏置。组装时应保持洁净并采取防静电措施，载体热膨胀系数应与 SiC 裸片相适应。 外形与已标注坐标的尺寸参考图，尺寸单位为 mm。制造及引线键合须依据完整的专用图纸。

键合焊盘尺寸

1 RFin: 100 × 100 µm; 2 RFout: 100 × 100 µm; 3,6 Vg: 100 × 100 µm; 4,7 Vd1: 100 × 80 µm; 5 Vd2: 180 × 180 µm.

机械外形尺寸图



性能曲线

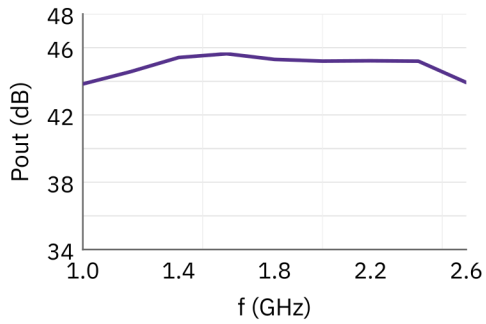
请结合每张图标明的工作条件阅读。

小信号增益、饱和输出功率、功率附加效率、功率增益、动态漏极电流、输入匹配。

图注： Vd=+28V; Vg=-2.6V。 Pout/PAE/Id/Gp: Pin = 20 dBm; S21/S11: Pin = -20 dBm. Pout 纵轴标为 dB，曲线的绝对功率单位未标明。输入匹配纵轴为 dB(S11)。 图中读数为近似值。

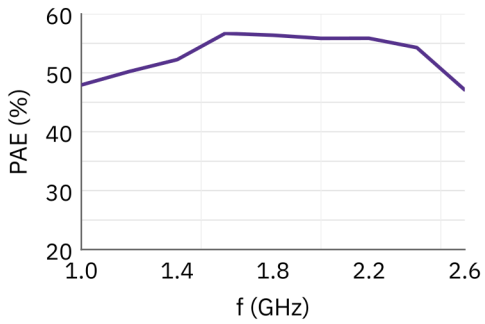
Pout

Pin = 20 dBm



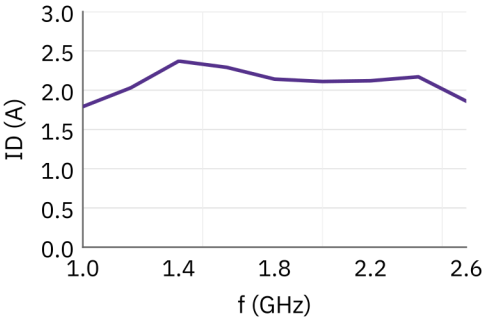
PAE

Pin = 20 dBm



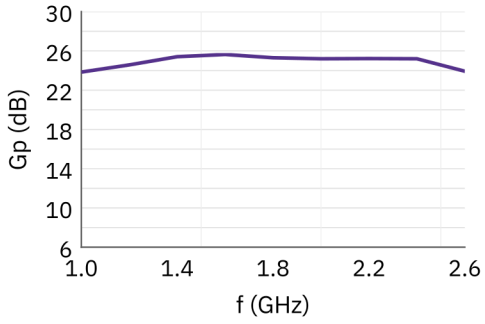
ID

Pin = 20 dBm



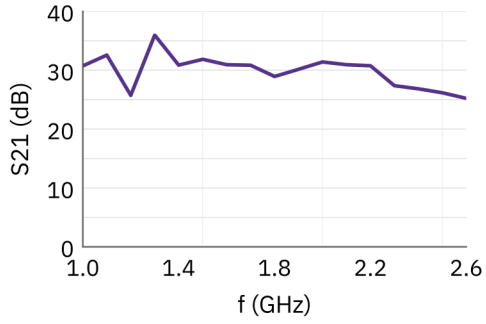
Gp

Pin = 20 dBm



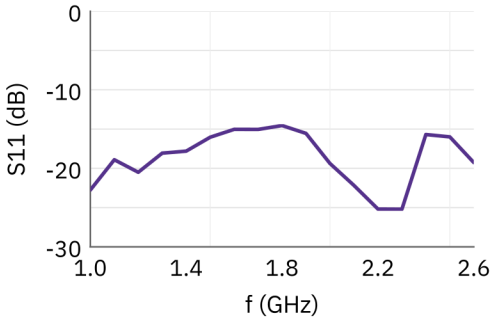
S21

Pin = −20 dBm



S11

Pin = −20 dBm



文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。